



2025年12月期決算説明

2026年2月13日

代表取締役社長 川上 潤

取締役副社長 尾形 潔



Rigaku

見るチカラで、世界を変える

本資料は、リガク・ホールディングス株式会社（以下「当社」といいます）の企業情報等の提供のために作成されたものであり、米国、日本国またはそれ以外の一切の法域における当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。米国、日本国またはそれ以外の一切の法域において、適用法令に基づく登録若しくは届出またはこれらの免除を受けずに、当社の有価証券の募集または販売を行うことはできません。

本資料には、当社または当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述には、「予想」、「予測」、「予定」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」やこれらの類義語が含まれることがありますが、これらに限られるものではありません。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報をもとに、本資料の作成時点における当社の判断に基づいて記載したものであり、また、一定の前提・仮定の下になされています。そのため、これらの記述または前提・仮定は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の結果はこれと大幅に異なる可能性があります。このリスクや不確定要素には、例えばX線分析機器の需要の悪化、当社のブランド、製品およびサービスに関するレピュテーション、市場における競争状況、海外事業展開に伴うリスク、物価変動、為替変動、労働コストの変動、規制動向、事業成長戦略の遂行可能性、個人情報・機密情報の保護、裁判手続等の動向、大規模災害の発生その他の要因が含まれます。

当社の現在の決算期は12月末であります。また、当社は、2022年1月1日を移行日として、2023年12月期より国際財務報告基準（以下「IFRS」といいます）を採用しております。

本資料には、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後営業利益、調整後営業利益率、研究開発費比率、設備投資額比率、調整後当期利益、フリーキャッシュ・フローなど、当社のNon-IFRS指標に関する記述がありますが、これらはIFRS、日本基準その他の会計基準に基づく財務数値に代替するものではありません。かかるNon-IFRS指標の当社における使用、定義および算定は、他社における同様の名称の財務指標とは大きく異なる可能性があり、直接的に比較することはできません。これらの財務数値の算出根拠等の詳細についてはAppendixをご参照ください。また、本資料には、製品区分別売上収益および営業利益並びにエンドマーケット別売上収益等の管理会計ベースの財務情報が含まれています。当該財務情報は日本基準またはIFRSに基づき作成されたものではなく、監査を受けたものでもありません。

なお、本資料における記述は本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。そのため、本資料に記載されている将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業等に関する情報は、公開情報または第三者が作成したデータ等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について、当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。

【アジェンダ】

1. 2025年12月期連結決算概要
2. 2026年度業績予想と事業戦略

1. 2025年12月期連結決算概要

全社

- 特に半導体プロセスコントロール機器の成長が牽引し4Qで大幅売上増。年間売上は業績予想通りに着地し、前年同期比(YoY) +4%の成長
- 調整後EBITDA/当期利益は4Qの売上増により大幅に改善。但し、年間では製造キャパシティ増やR&D等への戦略投資、及び製品・地域ミックスの変化の影響等によりYoYで減少。

多目的
分析機器

- リードタイムの一層の改善と的確な案件納入対応により、4Qで想定した売上を実現
- 市場のサイクル、及び米国政策の影響で厳しい環境の中、年後半での欧州、日本、中国の伸長により、年間売上は業績予想通りの水準(YoY (2)%)を確保

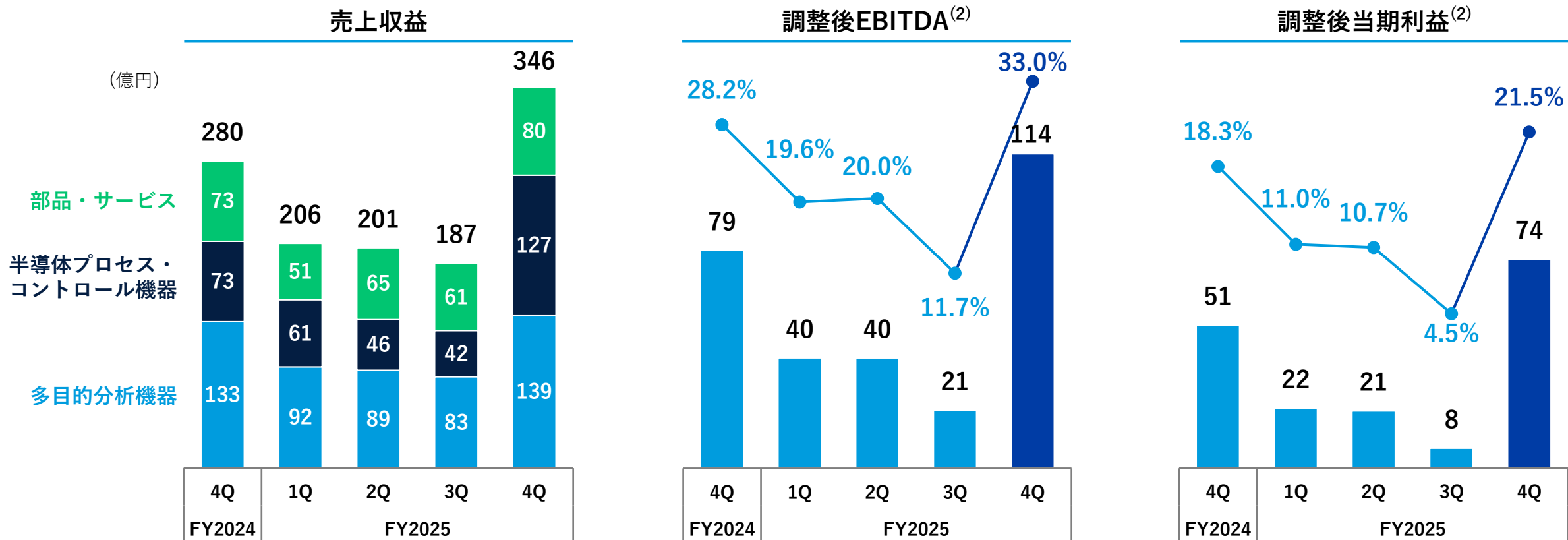
半導体
プロセス・
コントロール
機器

- 4Qは高採算案件を確実にクローズし大きく成長。想定を若干上回る売上を達成
- 量産から最先端技術の開発需要へのシフトを確実に捕捉し、年間売上はYoY +19%の高成長率を継続
- JEP⁽¹⁾の進捗とともに新製品群を発表、2026年度の成長への材料が整う

注：

1. Joint Evaluation Programの略称。新技術の評価を行うために、購入契約に先立ち顧客サイトに装置を導入し、要求される性能を有するかを合同で確認するプロセス。
確認できれば当装置の購入に繋がり、売上計上に伴い固定資産から売上原価に振り替えられる

■ 4Qは想定通りの大幅な売上増を達成し、調整後EBITDA/当期利益も4Qに大きく増大

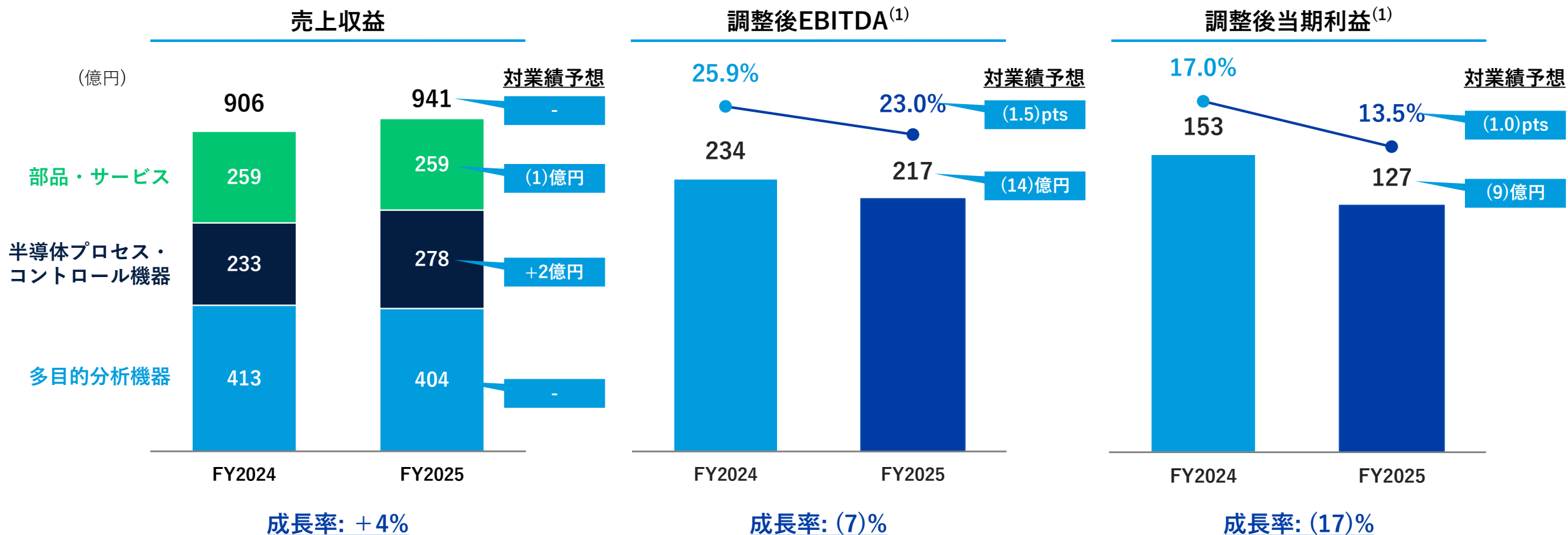


注：

1. 本資料において売上収益は億円以下を切り捨てているため、各事業の合計値と一致いたしません

2. Non IFRSの項目算出に関する調整項目についてはPage30、31に詳細を記載

- 売上は業績予想通りに着地し、前期比(YoY) +4%
- 調整後EBITDA/調整後当期利益は、製造キャパシティ増やR&D等の戦略投資、製品・地域ミックスの変化等の影響によりYoYで減少、業績予想に対しても未達(詳細は後述)

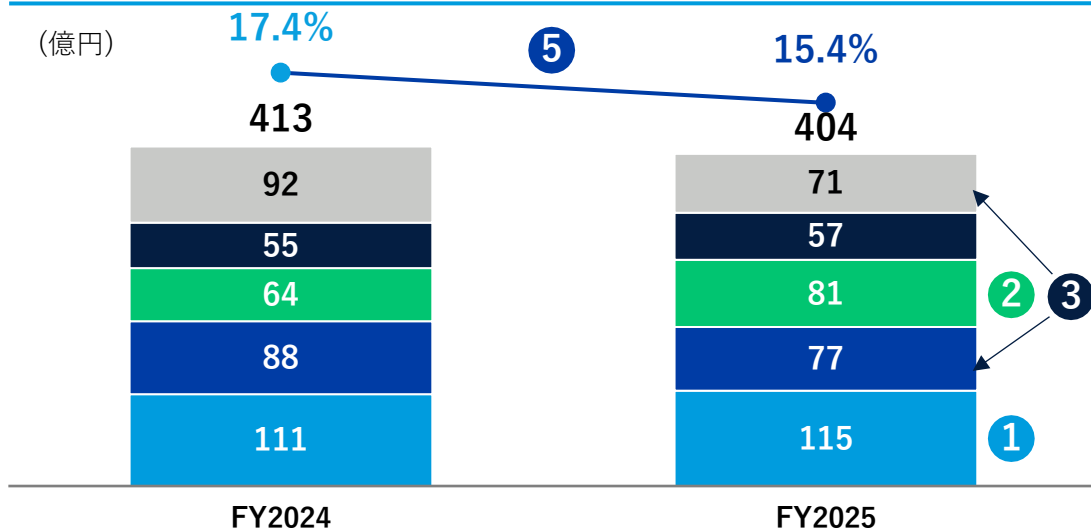


注:

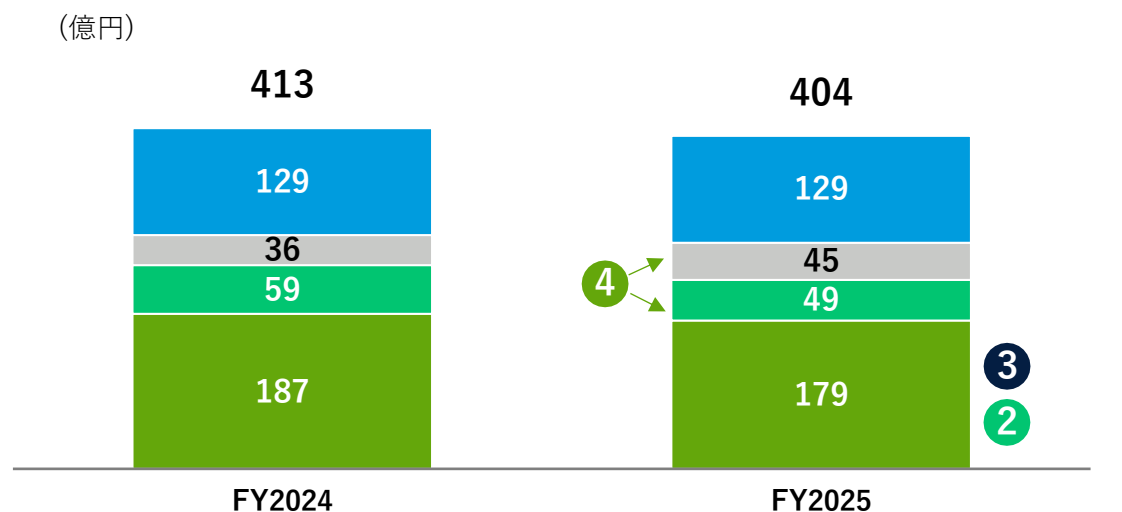
1. Non IFRSの項目算出に関する調整項目についてはPage30、31に詳細を記載

- 2025年度は、市場サイクル(前年度の中国補正予算案件やSiC市場の高需要からの反動)や米トランプ政策の影響による厳しい環境下も、年後半での欧州、日本、中国の伸長により年間ではYoY (2)%まで回復

地域別売上収益



エンドマーケット別売上収益



■ 日本 ■ 米州 ■ 欧州 ■ アジア(中国以外) ■ 中国 —●— 営業利益率
 ■ アカデミア/ガバメント ■ 半導体・電子部品 ■ ライフサイエンス ■ その他産業

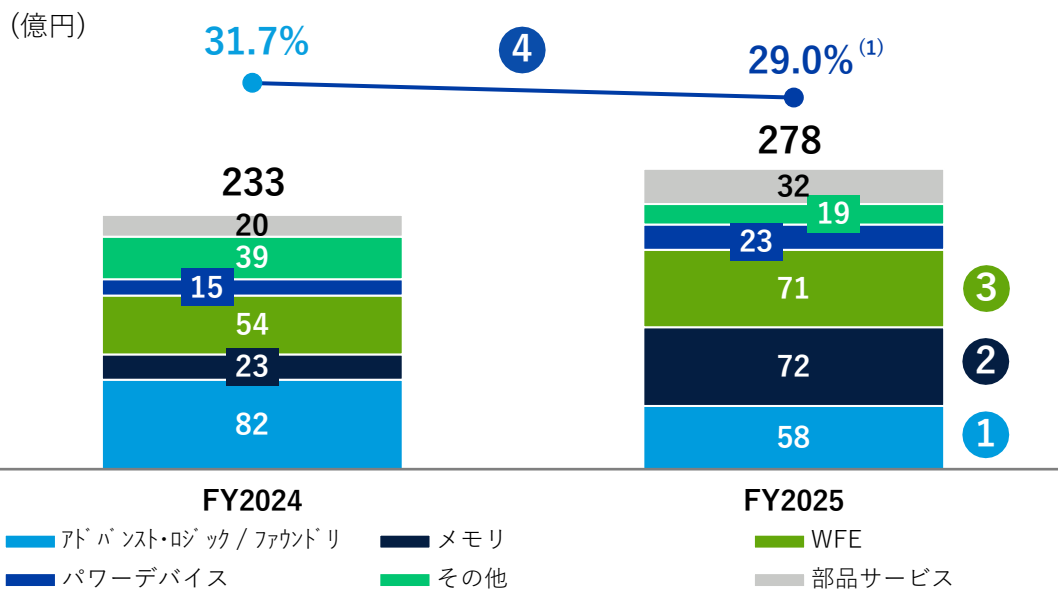
- ① 日本：4Q(10月-12月)でYoY +41%伸長し、年間ではYoY +3%成長
- ② 欧州：アカデミア市場での新材料、製造技術、サステナビリティ対応等のR&D需要を捕捉しシェア拡大。YoY + 27%成長
- ③ 米州：アカデミア予算削減の影響が4Qに発現し、YoY (13)%。中国は前年度の補正予算案件の反動により通年ではYoY (23)%
- ④ ライフサイエンスは化学製品や米州製薬市場での需要を捕捉し売上増。半導体・電子部品はSiC市場環境の変化で売上減
- ⑤ GM⁽¹⁾率はほぼフラット。売上減と戦略投資により営業利益率は低下したが、(2)ptsの低下に留める

注：

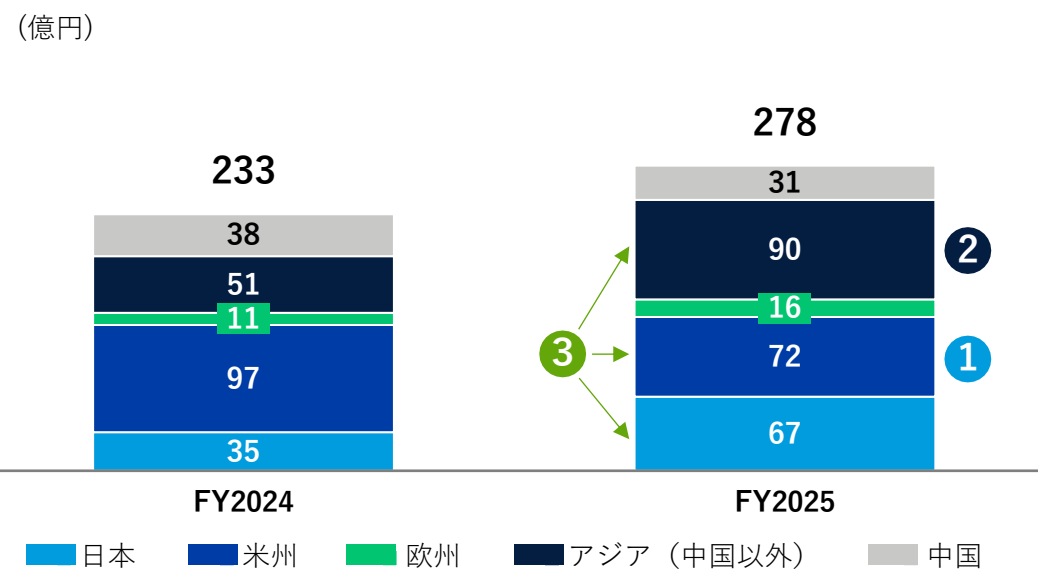
1. 2025年第1四半期連結会計期間より、従来販売費及び一般管理費で計上していた販売先での納入等フィールドサービス関連費用を売上原価に計上する方法へ変更。本資料では当該変更を前年同期についても遡及適用

- 4Qは次世代技術開発向け新製品や大型案件を確実にクローズし想定通りの大幅ボリューム増
- 年間では、量産から研究開発への需要シフトを確実に捕捉し、高い成長率を継続して実現(YoY +19%)

アプリケーション別売上収益



地域別売上収益



- ① ロジック: 米州で低下したが、アジア/日本は拡大
- ② メモリ: アジアにおけるDRAM・NANDが牽引し、前年対比で大幅に伸長(量産、開発両面で)
- ③ WFE: 次世代技術開発案件により4Q/年間で大幅に増大
- ④ 製品・地域ミックスの影響によりGM率⁽¹⁾/営業利益率は対前年で減となるが、事業成長により29%の高い営業利益率を確保

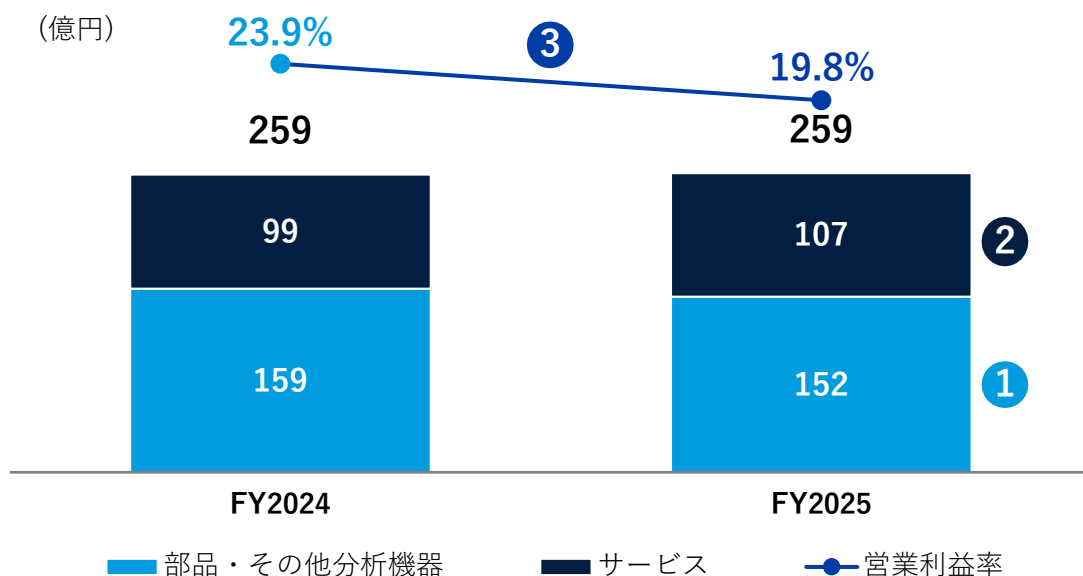
注:

1. 2025年第1四半期連結会計期間より、従来販売費及び一般管理費で計上していた販売先での納入等フィールドサービス関連費用を売上原価に計上する方法へ変更。本資料では当該変更を前年同期についても遡及適用

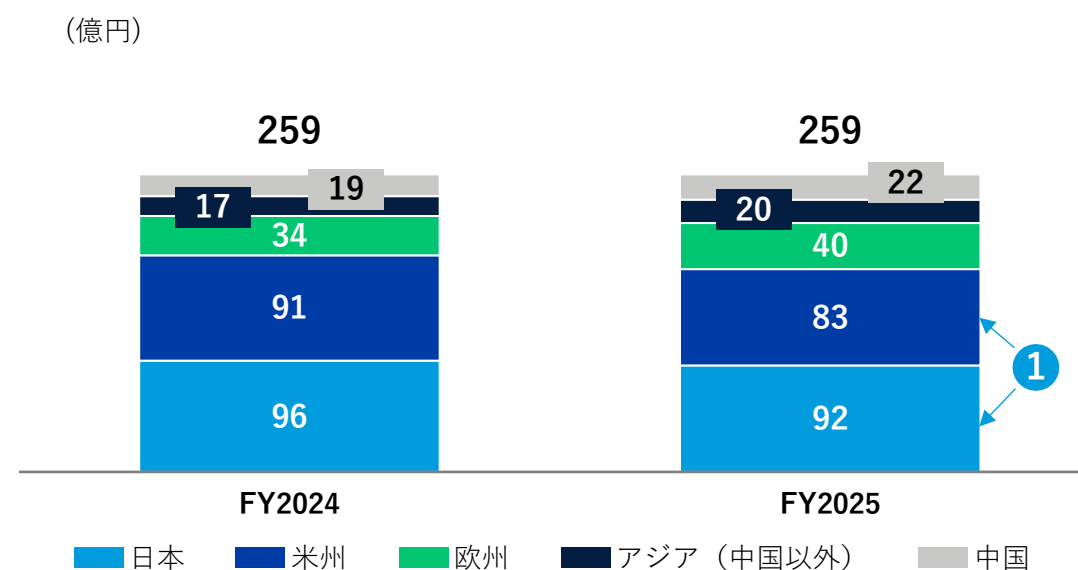
■ 売上収益は対前年フラット。EUV向け多層膜ミラーを除けばYoY +4%

■ サービス売上は +8%の成長

部品・その他分析機器/サービス売上収益

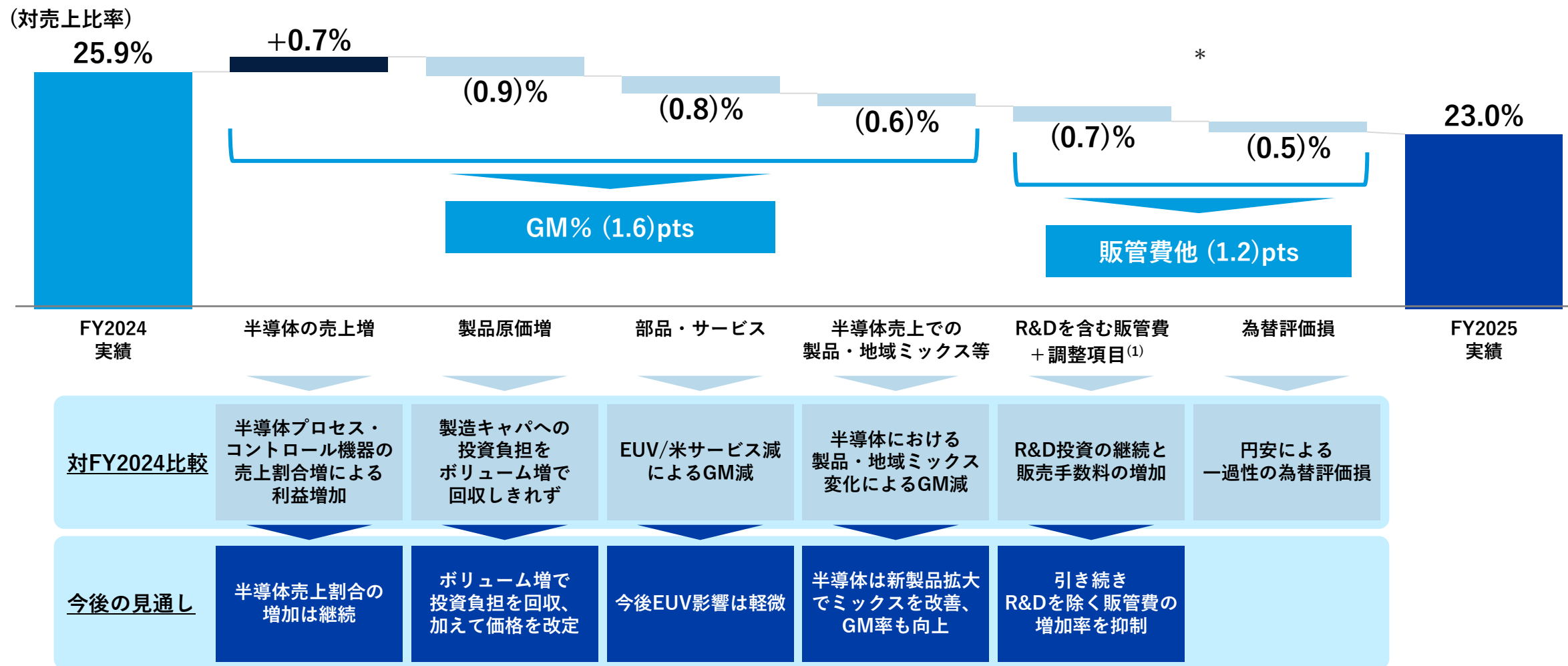


地域別売上収益



- ① EUV向け多層膜ミラーは需要低迷により売上減 ((10)億円)。EUVを除く売上は、その他分析機器(熱分析、PCI、携帯用ラマン分光)の売上増が戦略変更に伴う部品の売上減を上回り、3億円の増加
- ② サービス：価格引き上げとグローバルでの保守サービス契約の拡販、インストールベースの増大により、堅調に成長
- ③ 利益率の低下は、EUVの売上減によるミックス悪化、トランプ政策の影響を受けた米国でのサービス利益率低下などによる影響

EBITDAマージンの変動要因分析(YoY)



注：

1. 営業利益から調整後EBITDAへの調整

2. 2026年度業績予想と事業戦略

	2025年12月期	2026年12月期 ⁽¹⁾
	実績	予想
売上収益 (前年比成長率)	941億円 3.9%	1,010億円 7.2%
調整後EBITDA (調整後EBITDAマージン)	218億円 23.0%	253億円 25.1%
調整後営業利益 (調整後営業利益率)	186億円 19.8%	215億円 21.3%
調整後当期利益 (調整後当期利益率)	127億円 13.5%	139億円 13.8%
調整後ROE	14.9%	15.0%
研究開発費比率	7.8%	8.5%
設備投資額比率	7.1%	7.7%
要員数	2,226人	2,351人
1株当たり配当金	18.8円	19.0円
JPY/USD	149.8円	145.0円
JPY/EURO	169.5円	165.0円

全社

- 売上収益は実質 +9%⁽²⁾で中期経営計画並みの成長
- GM率拡大でR&Dを含む販管費の増加を吸収し、調整後EBITDAマージン/営業利益率/当期利益率を向上させる戦略は不変
- 引き続き2027年度に中計の目標達成を目指す

多目的 分析機器

- 米アカデミア市場の急速な回復を前提としないものの、市場全体は安定成長に回帰するなかで実質 +4%⁽²⁾成長を計画
 - 米州と中国で増収、日本・欧州は前年並みを確保
 - インダストリー向け拡大でアカデミア向け減収を吸収
 - 製品ミックスの改善、価格政策により売上成長とGM率改善

半導体 プロセス・ コントロール 機器

- AI用途の半導体の旺盛な需要を背景に実質 +21 %⁽²⁾成長
- 新製品は2.2倍増、AI用途比率は71%へ
- 新製品の貢献拡大によりGM率は2.0pts向上

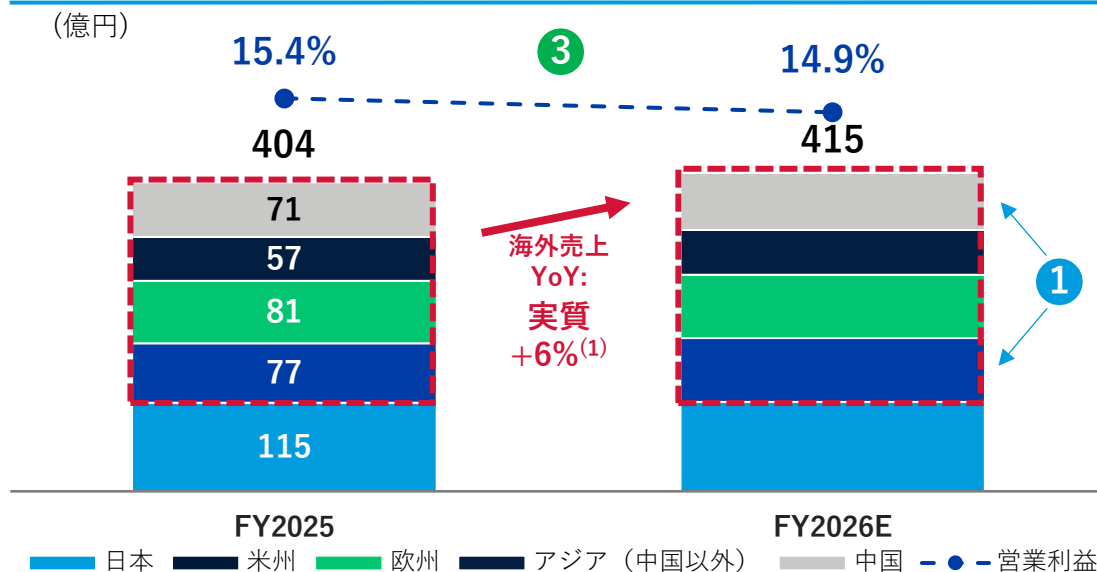
注：

1. 対米ドル為替感応度：売上収益約2億円、営業利益約0.4億円(米国子会社からのドル建て借入金にかかる評価損益を含む)、対ユーロ為替感応度：売上収益約0.7億円、営業利益約0.3億円

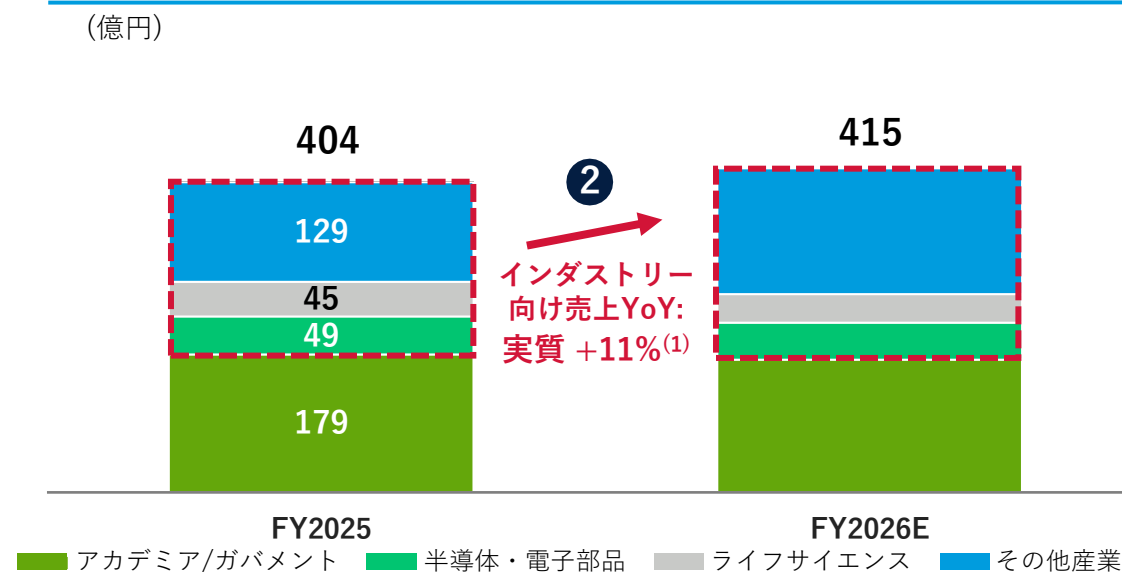
2. 前年度と同等の為替で比較した場合

- グローバル市場が安定成長に回帰するなか、インダストリーへのシフト、およびMI(マテリアル・インフォマティクス)向けニーズ取り込みで海外でのシェアゲインを継続(海外売上 実質 +6%成長⁽¹⁾)

地域別売上収益推移



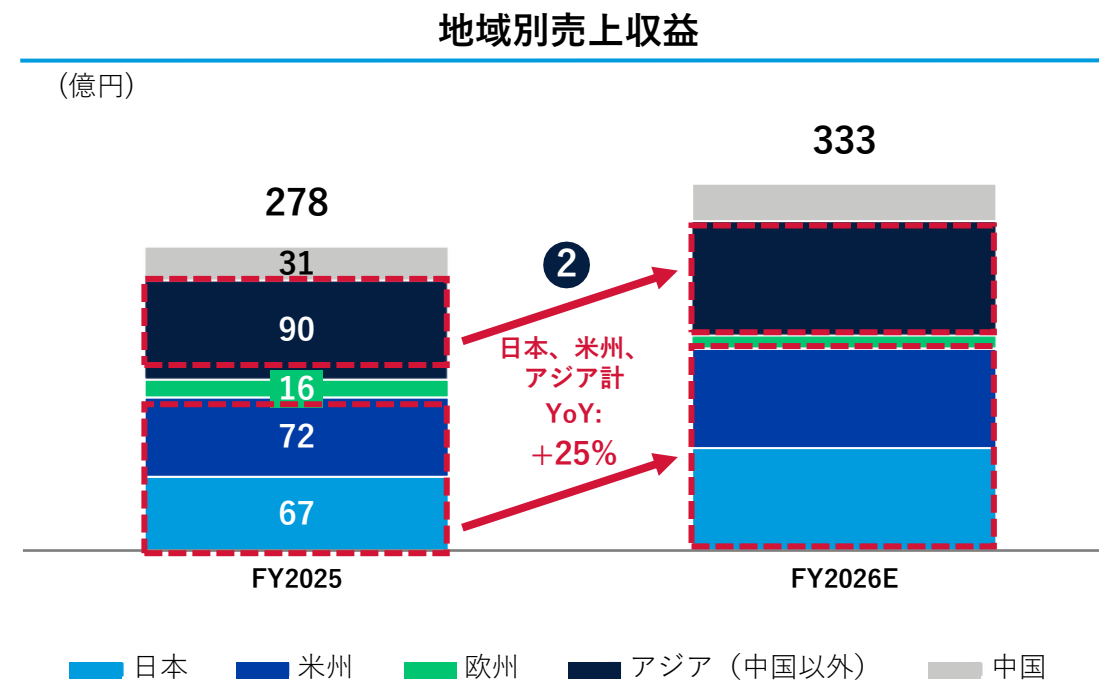
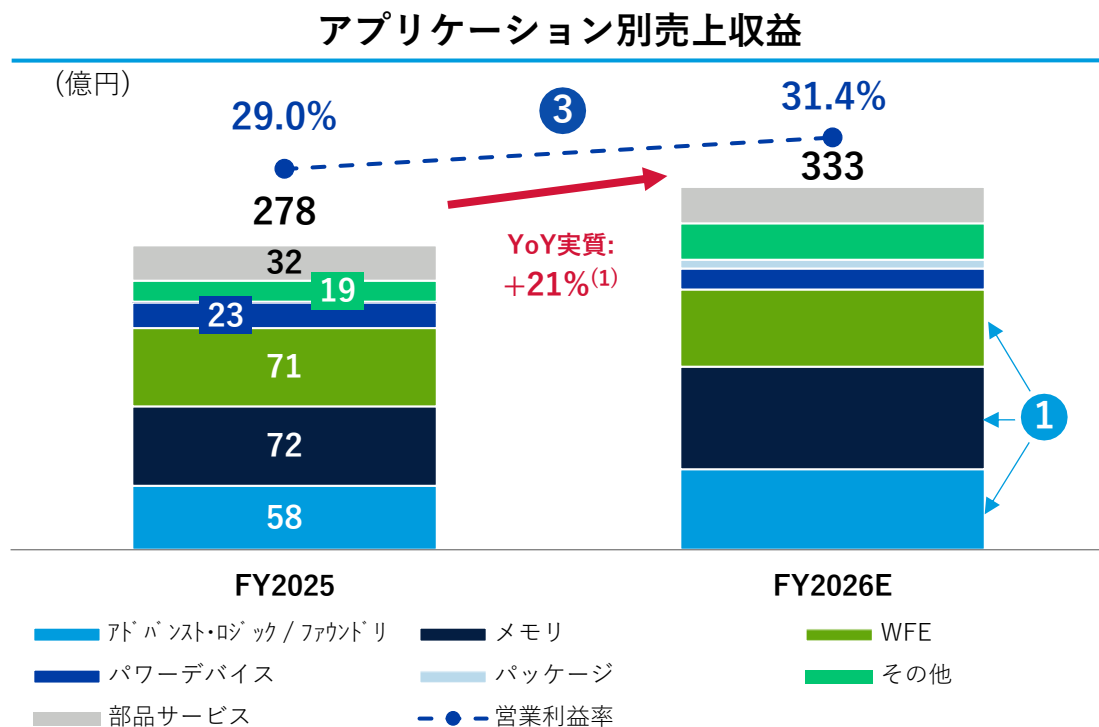
エンドマーケット別売上収益



- ① 地域別では、米州も2024年度の水準に戻り、中国も増収に転じる
- ② エンドマーケット別ではリソースシフトにより、半導体・電子部品等中心にインダストリー向け拡大、アカデミアの減収を吸収
- ③ GM率は広範な製品における価格政策、半導体・電子部品向け売上増等によるミックス改善などにより、FY2025より1.8pts改善。
一方で、営業利益は海外コマーシャル・インフラやR&D投資継続で微減

注：
1. 前年度と同等の為替で比較した場合

- AI用途の半導体の旺盛な需要を背景に新製品売上がYoYで2.2倍に増加、実質+21%⁽¹⁾成長を目指す



■ 活発な新製品導入活動により、AI用途半導体向け比率はさらに高まる

売上高に対する新製品の比率

(億円)

JEP⁽¹⁾ 案件数

14件

(5件はFY25で終了)

現時点で

12件

(今後増加予定)

333

278

24%

金額
YoY:
2.2倍

41%

XTRAIA XD-3300
XTRAIA MF-3400
ONYX 3200
XTRAIA CD3200-T
⋮

FY2025

FY2026E

AI用途半導体向け売上比率(当社推定)

(億円)

278

60%

金額
YoY:
1.4倍

333

71%

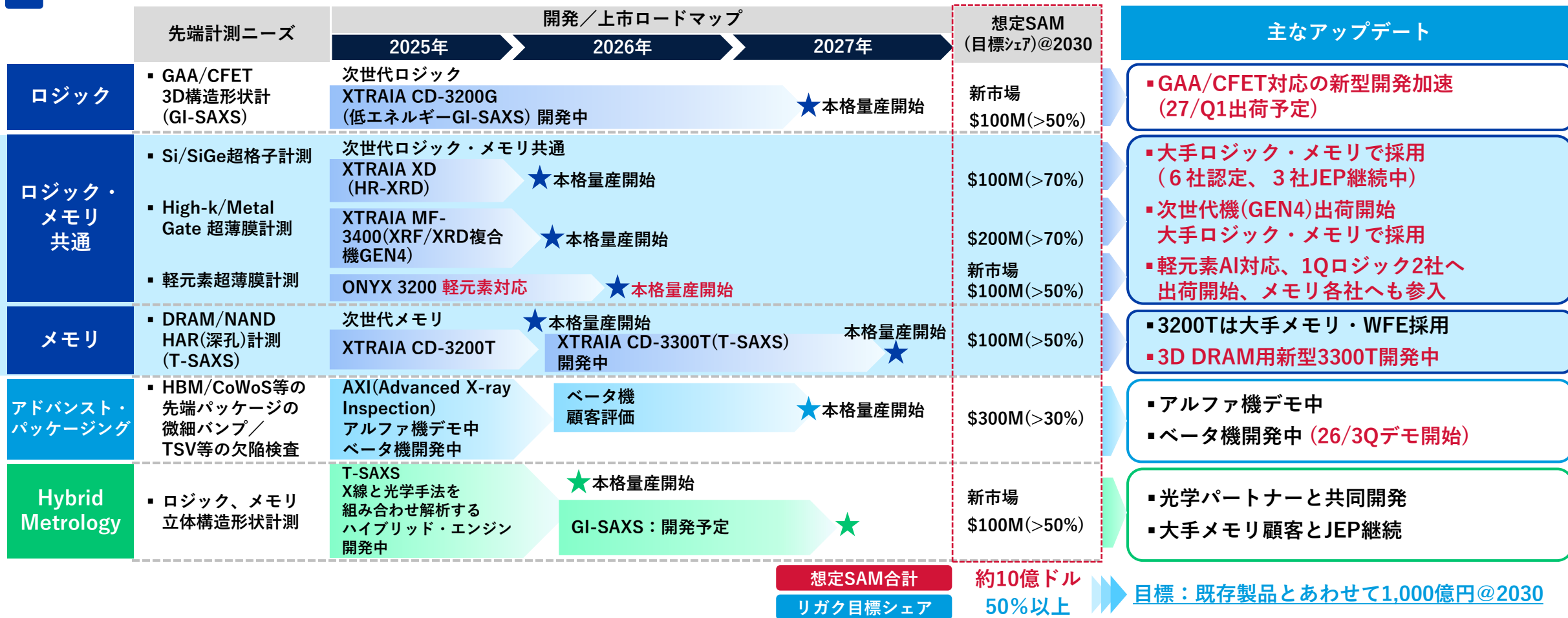
FY2025

FY2026E

注：

1. Joint Evaluation Programの略称。新技術の評価を行うために、購入契約に先立ち顧客サイトに装置を導入し、要求される性能を有するかを合同で確認するプロセス。
確認できれば当装置の購入に繋がり、売上計上に伴い固定資産から売上原価に振り替えられる

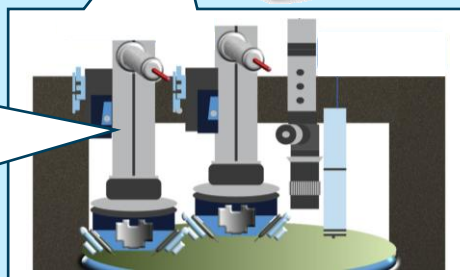
- AI半導体増産投資の捕捉：2nmロジック、HBM/3D NANDメモリ増産
- 次世代半導体開発投資の捕捉：≦1nmロジック、次世代メモリ（3D DRAM他）、先端PKG
- 新製品：2025年開発完製品のロジック・メモリへの展開、軽元素対応 ONYX 3200開発完、JEP開始 他



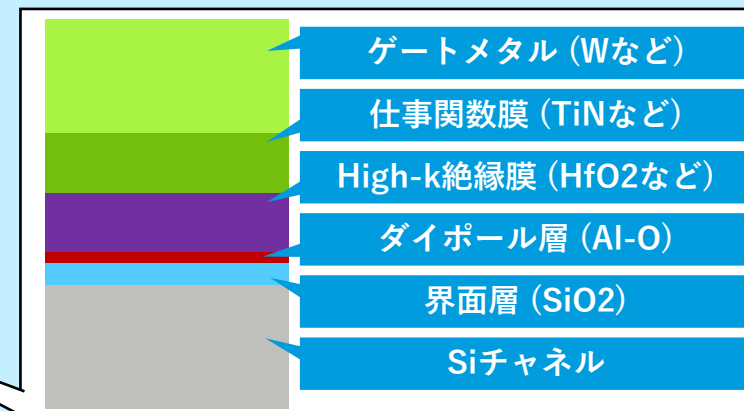
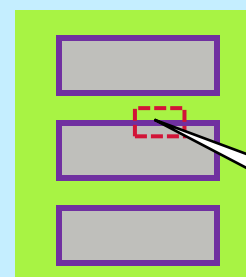
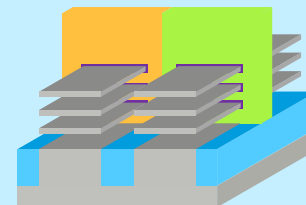
- 先端トランジスタGAA/CFETの性能・信頼性を決定するAl-Oダイポール層の膜厚を多層膜状態で高スループット、高精度に計測できる技術を開発
- 2026年に先端半導体ロジック顧客2社に出荷、メモリ顧客にも順次展開

軽元素対応 超薄膜計測：ONYX 3200

X線ビームモジュール
“COLORS-t W M α ”



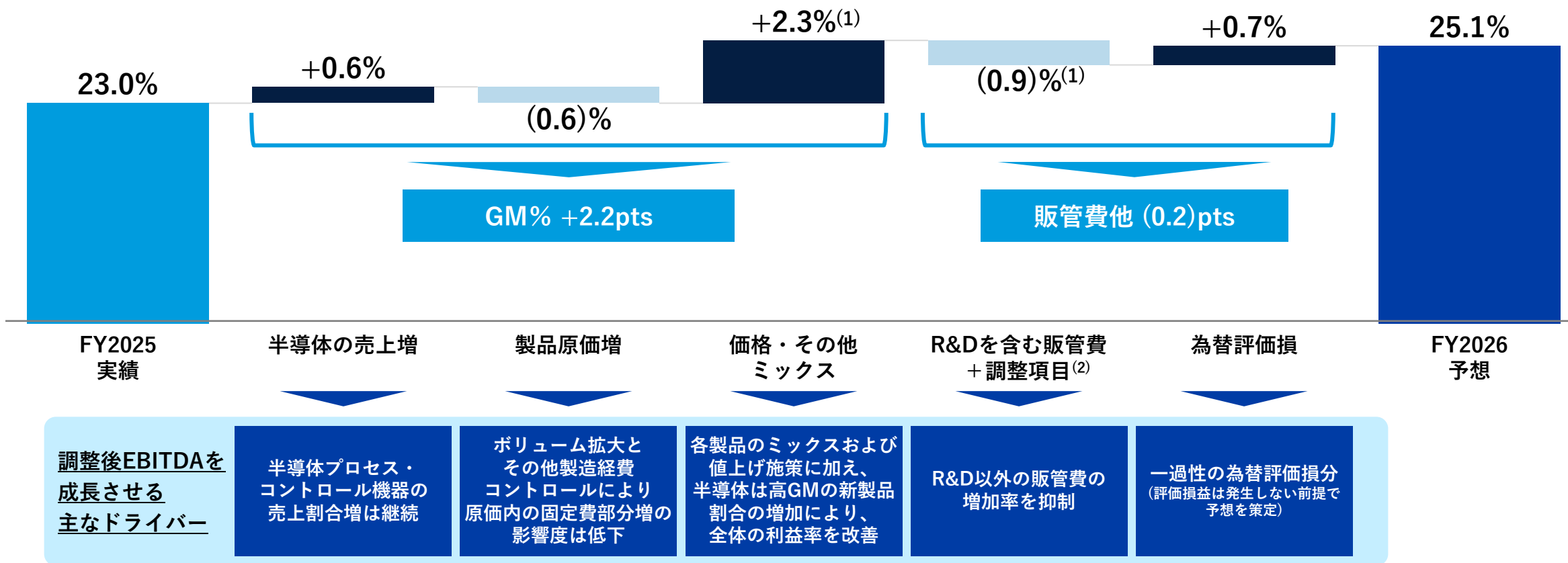
先端トランジスタGAA/CFETの構造模式図



- 軽元素Alの膜厚を高精度に計測できる新X線ビームモジュール“COLORS-t W M α ”を開発
- 従来手法XPSは超高真空下で極表面層のみ計測 → 低スループット、多層膜中Al計測不可(従来課題)
- ONYX 3200は大気中で多層膜中の計測可能 → 高スループット、多層膜中Al計測が可能

EBITDAマージンの変動要因分析

(対売上比率)

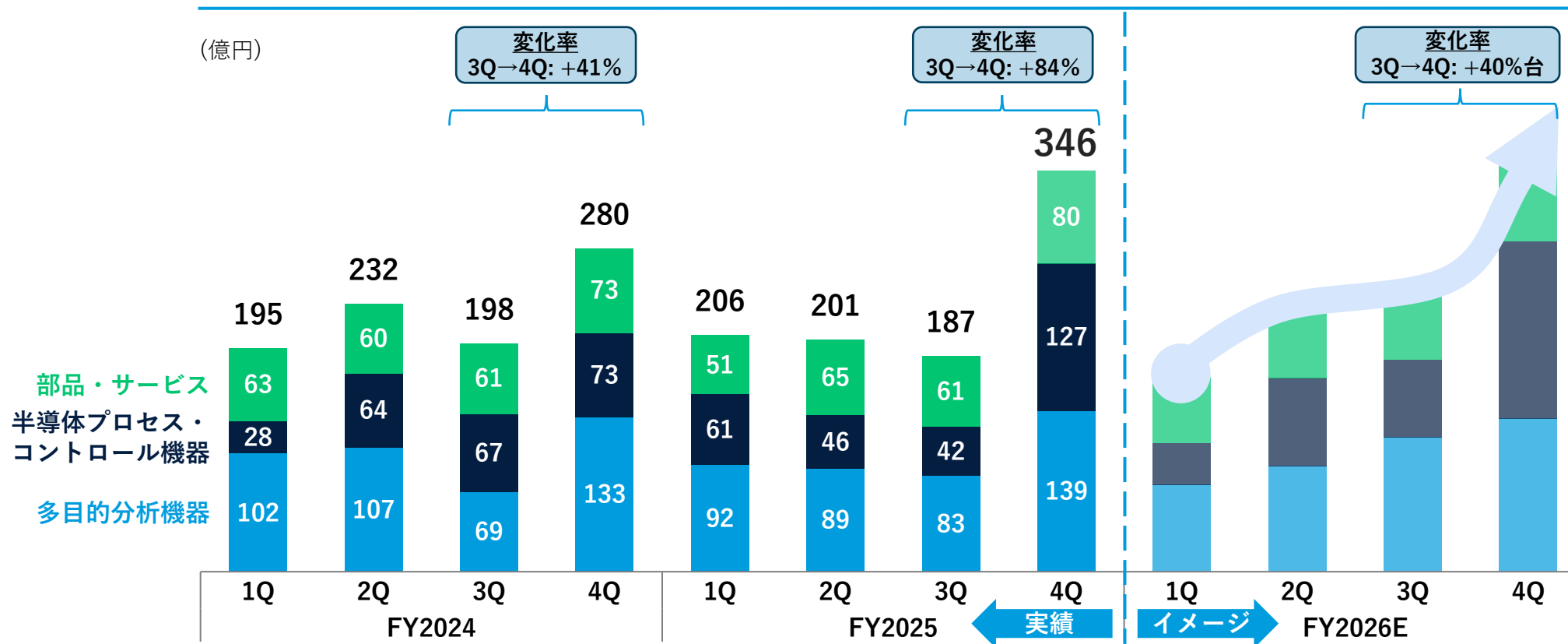


注：

- +0.3%相当のサービス技術サポート費用の原価から販管費への変更含む
- 営業利益から調整後EBITDAへの調整

- 2025年度4Qは過去最高の売上を記録
- 2026年度の売上トレンド：低位スタート後切り返して上期で前年並み、下期はYoY +14%と急拡大
- 2026年度も4Qがピークとなる見込みも、2Q - 3Qが前年を上回り、四半期(3Q→4Q)変動率は2024年度並みに回帰 (FY2025 +84% → FY2026 40%台)

四半期別売上推移/予想



配当性向および配当金について

■ 配当性向

当社は、中長期の経営視点から成長投資の推進と財務健全性の確保とのバランスを考慮しつつ、各期の業績に応じて当期連結利益の30%を目途に株主への配当を実施していくことを、引き続き基本方針とする

■ 配当金

2025年度配当は期末配当は期初予想通りの9.4円、年間配当は18.8円

2026年度配当は年間配当予想は19.0円(中間9.5円、期末9.5円)を予定

自己株式取得について⁽²⁾

2025年度において、持続的な企業価値向上に向けた取り組みの一環として、また、株主還元策強化の観点から、自己株式取得を実施

- 4,284,500株(約40億円)を取得
- 2026年1月28日付けで全株の消却を決議済み

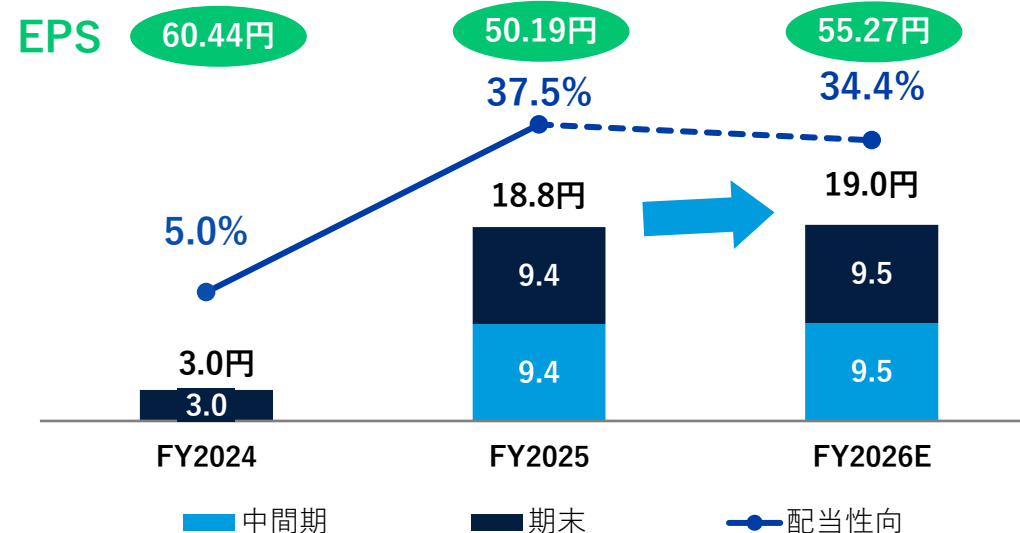
注：

1. FY2024の配当金は2024年10月24日上場後2か月分に相当

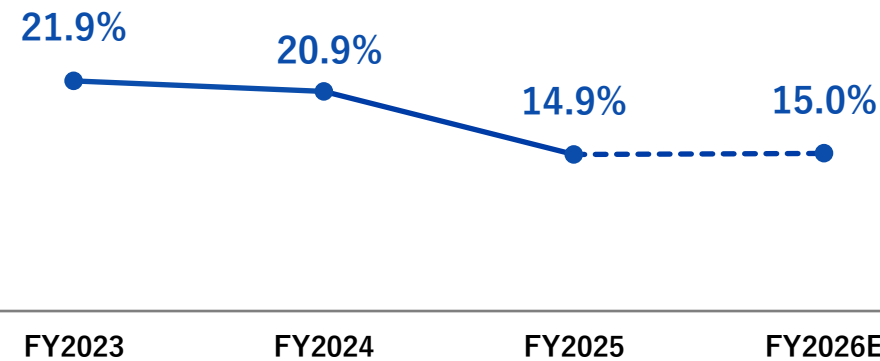
2. 2025年12月24日付適時開示「自己株式取得状況および取得終了に関するお知らせ」及び 2026年 1月28日付適時開示「自己株式の消却に関するお知らせ」に基づく

3. ROE = 調整後税引後当期純利益 ÷ 自己資本(期首期末平均)

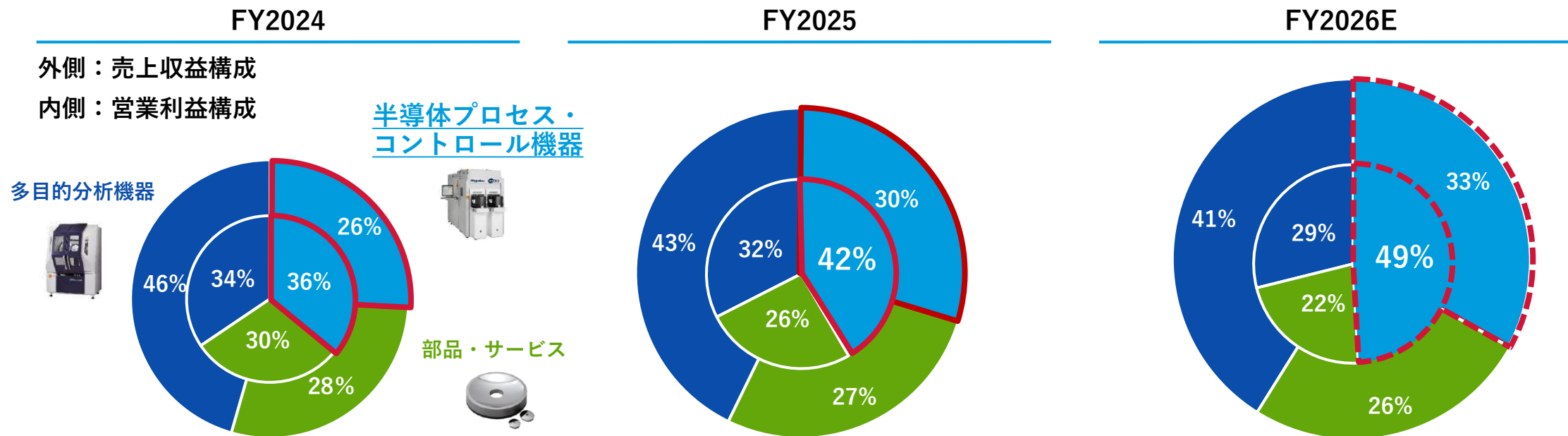
配当金の推移⁽¹⁾



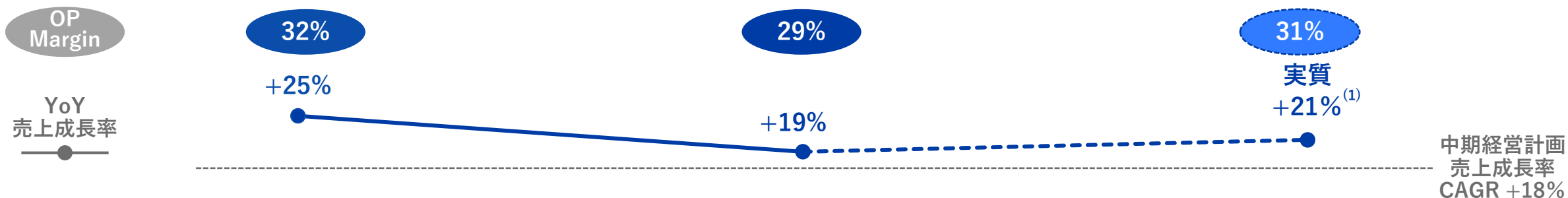
調整後自己資本利益率 (ROE) ⁽³⁾



■ 中期経営計画の進捗とともに事業構造が進化、半導体プロセス・コントロール機器事業が収益の柱に



■ 半導体プロセス・コントロール機器事業：高マージンの事業成長が中計想定を上回るペースで続く

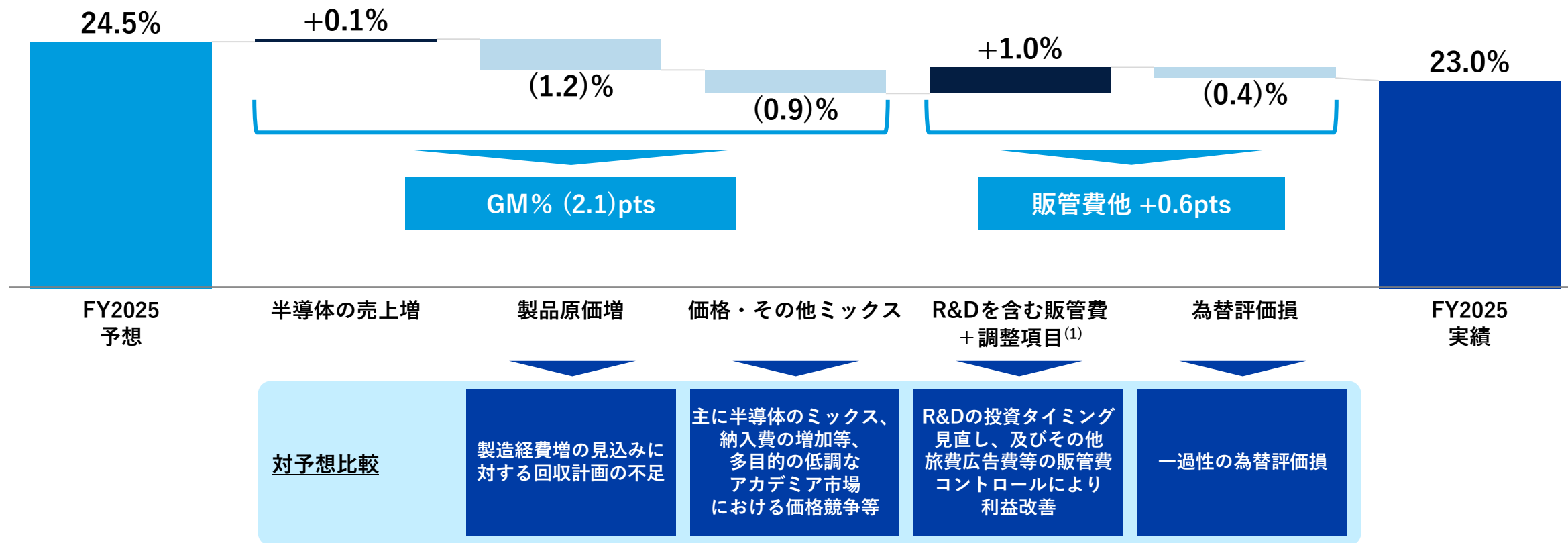


注：
1. 前年度と同等の為替で比較した場合

Appendix

EBITDAマージンの変動要因分析

(対売上比率)



注：

1. 営業利益から調整後EBITDAへの調整

	項目	備考
第 1 号議案	<ul style="list-style-type: none"> 取締役 7 名選任 	<ul style="list-style-type: none"> 独立社外取締役 5 名、社内取締役 2 名選任 独立社外取締役のうち 1 名退任、1 名新任
第 2 号議案	<ul style="list-style-type: none"> 監査役 2 名選任 	<ul style="list-style-type: none"> 常勤監査役 1 名退任、常勤監査役 2 名新任 4 名体制に強化(常勤 2 名、非常勤 2 名)
第 3 号議案	<ul style="list-style-type: none"> 取締役(社外取締役を除く)に対する事後交付型株式報酬の額の算定方法および内容決定 	<ul style="list-style-type: none"> 事後交付型株式報酬制度の導入に伴い、本制度にかかる取締役(社外取締役を除く)の報酬について、年額上限を 2 億円以内、株数上限を 100,000 株とする
第 4 号議案	<ul style="list-style-type: none"> 監査役の報酬総額決定 	<ul style="list-style-type: none"> 監査役の人員体制の強化に伴い、年間の報酬総額を 8,000 万円(従来 5,000 万円)以内とする

(億円)	FY2024					FY2025					FY2026E
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
多目的分析機器											
売上収益	102	107	69	133	413	92	89	83	139	404	415
営業利益	21	16	0	32	71	12	13	4	31	62	62
営業利益率	21.2%	15.6%	0.6%	24.7%	17.4%	13.6%	15.0%	5.4%	22.7%	15.4%	14.9%
半導体プロセス・コントロール機器											
売上収益	28	64	67	73	233	61	46	42	127	278	333
営業利益	4	22	27	19	74	16	8	0	56	80	104
営業利益率	14.6%	35.3%	41.0%	26.8%	31.7%	26.3%	17.9%	-	44.7%	29.0%	31.4%
部品・サービス											
売上収益	63	60	61	73	259	51	65	61	80	259	260
営業利益	12	20	11	17	61	5	15	11	18	51	47
営業利益率	19.4%	33.4%	19.0%	24.0%	23.9%	11.2%	23.3%	19.0%	23.2%	19.8%	18.3%
連結合計											
売上収益	195	232	198	280	906	206	201	187	346	941	1,010
営業利益	31	55	31	65	183	28	28	8	101	167	194
営業利益率	16.3%	23.7%	16.0%	23.2%	20.3%	13.8%	14.3%	4.5%	29.2%	17.7%	19.3%

注：

1. 本情報は、投資家の皆さまの理解のために参考情報として作成したものであり、本社費を加味していないため、連結営業利益は各カテゴリーの合計値と一致しません

地域別売上収益

(億円)	FY2024					FY2025				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
日本	77	58	43	63	243	77	41	48	107	274
米州	48	65	71	91	277	45	59	40	89	234
欧州	20	36	17	36	110	27	38	26	46	138
アジア(中国以外)	19	21	34	48	124	31	30	37	69	168
中国	29	50	31	40	150	23	32	34	35	125
売上収益合計	195	232	198	280	906	206	201	187	346	941

エンドマーケット別売上収益

(億円)	FY2024					FY2025				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
半導体・電子部品	48	97	81	97	324	77	61	49	143	333
ライフサイエンス	11	9	8	14	43	9	8	13	19	50
その他産業	47	32	33	50	164	34	35	35	51	157
アカデミア/ガバメント	55	59	41	83	239	46	59	51	91	248
サービス	32	32	33	35	135	37	36	37	41	151
売上収益合計	195	232	198	280	906	206	201	187	346	941

注：

1. 海外の顧客・代理店に対する売上収益に基づき算出
2. 過年度分エンドマーケット売上収益の分類調整後

(億円)	FY2024					FY2025					FY2026E
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
売上収益	195	232	198	280	906	206	201	187	346	941	1,010
売上総利益 ⁽¹⁾	106	138	117	162	523	115	111	97	204	528	589
営業利益	31	55	31	65	183	28	28	8	101	167	194
税引前利益	30	54	30	64	179	27	27	6	98	159	184
当期利益	21	43	24	46	136	19	18	4	71	114	125
EPS (円)	-	-	-	-	60.44	-	-	-	-	50.19	55.27
Non-IFRS 指標⁽²⁾											
調整後営業利益	37	61	37	72	209	33	33	13	106	186	215
調整後当期利益	26	47	28	51	153	22	21	8	74	127	139
調整後EPS (円)	-	-	-	-	66.61	-	-	-	-	55.19	61.40
EBITDA	43	67	43	78	232	40	41	21	115	218	253
調整後EBITDA	43	67	44	79	234	40	40	21	114	217	253
対売上収益比率	22.3%	29.2%	22.3%	28.2%	25.9%	19.6%	20.0%	11.7%	33.0%	23.0%	25.1%
調整後ROE	-	-	-	-	20.9%	-	-	-	-	14.9%	15.0%
研究開発費	14	17	15	21	68	16	18	18	19	73	85
設備投資額	5	23	7	27	63	6	34	10	15	66	77
減価償却費	12	12	11	12	48	12	12	13	13	51	58
JPY/USD	149.9	154.1	151.6	152.2	152.2	151.2	147.5	147.8	149.8	149.8	145.0
JPY/EURO	162.2	166.1	164.6	164.4	164.4	159.4	162.2	165.6	169.5	169.5	165.0

注：

1. 2025年第1四半期連結会計期間より、従来販売費及び一般管理費で計上していた販売先での修理・納入等フィールドサービス関連費用を売上原価で計上する方法に変更。本資料では当該変更を前年同期についても遡及適用(2,923百万円を販売費及び一般管理費から売上原価に変更)して表示

2. Non IFRSの項目算出に関する調整項目についてはPage30、31に詳細を記載

B/S

(億円)	FY2024期末	FY2025期末	増減額
流動資産	712	762	50
現預金	279	242	(37)
棚卸資産	211	208	(2)
非流動資産	1,063	1,089	26
有形固定資産	192	226	33
無形資産	870	863	(7)
資産合計	1,775	1,852	76

(億円)	FY2024期末	FY2025期末	増減額
負債	957	968	10
有利子負債	616	621	5
資本合計	817	883	66
負債・資本合計	1,775	1,852	76

キャッシュ・フロー

(億円)	FY2024	FY2025	増減額
営業キャッシュ・フロー	146	93	(52)
投資キャッシュ・フロー	(60)	(66)	(5)
フリーキャッシュ・フロー	85	27	(57)
財務キャッシュ・フロー	(24)	(65)	(41)
為替換算差異	13	1	(12)
ネットキャッシュ・フロー	74	(37)	(111)

財務指標

	FY2024	FY2025	増減額
ネットデット / 調整後EBITDA ⁽¹⁾	1.4x	1.7x	-
自己資本比率	46.1%	47.7%	-

注：

1. 2025年12月期末の値はLTM合計の調整後EBITDAを用いて算出

(億円)	FY2024					FY2025					FY2026E
EBITDA	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
税引前利益	30	54	30	64	179	27	27	6	98	159	184
減価償却費及び償却費	12	12	11	12	48	12	12	13	13	51	69
支払利息	1	1	1	1	6	2	2	2	3	11	0
受取利息及び配当金	0	0	(1)	(1)	(3)	(1)	(1)	(1)	0	(4)	0
減損損失	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
EBITDA	43	67	43	78	232	40	41	21	115	218	253
利益率	22.2%	29.0%	22.0%	28.0%	25.7%	19.6%	20.4%	11.7%	33.2%	23.2%	25.0%
調整後EBITDA	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
EBITDA	43	67	43	78	232	40	41	21	115	218	253
コンサルティング・フィー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中国免除申請関連費用	0	0	0	(1)	(1)	0	(0)	0	(0)	(1)	0
上場関連費用	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
調整項目計	0	0	0	0	1	0	0	0	0	(1)	0
調整後EBITDA	43	67	44	79	234	40	40	21	114	217	253
利益率	22.3%	29.2%	22.3%	28.2%	25.9%	19.6%	20.0%	11.7%	33.0%	23.0%	25.0%

調整後利益等における調整項目(2/2)

(億円)	FY2024					FY2025					FY2026E
調整後営業利益	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
営業利益	31	55	31	65	183	28	28	8	101	167	194
PPA償却費	6	5	5	5	22	5	5	5	5	20	21
コンサルティング・フィー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中国免除申請関連費用	0	0	0	(1)	(1)	0	(0)	0	(0)	(1)	0
上場関連費用	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
減損損失	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
調整項目計	6	6	5	7	25	5	4	5	4	19	21
調整後営業利益	37	61	37	72	209	33	33	13	106	186	215
利益率	19.4%	26.4%	19.0%	25.8%	23.1%	16.3%	16.5%	7.2%	30.6%	19.8%	21.3%

調整後当期利益	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
当期利益	21	43	24	46	136	19	18	4	71	114	125
PPA償却費	6	5	5	5	22	5	5	5	5	20	21
コンサルティング・フィー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中国免除申請関連費用	0	0	0	(1)	(1)	0	(0)	0	(0)	(1)	0
上場関連費用	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
減損損失	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
調整項目計	6	6	5	7	25	5	4	5	4	19	21
調整項目に対する税金等調整	(2)	(2)	(1)	(2)	(7)	(1)	(1)	(1)	(1)	(6)	(7)
調整後当期利益	26	47	28	51	153	22	21	8	74	127	139
利益率	13.3%	20.4%	14.6%	18.3%	17.0%	11.0%	10.7%	4.5%	21.5%	13.5%	13.8%

Appendix – 用語集

用語	説明
AXI	<ul style="list-style-type: none"> Automated X-Ray Inspectionの略称。X線を用いた自動検査装置。電子基板や半導体内部の欠陥を非破壊で検出し、品質管理を効率化する
CFET	<ul style="list-style-type: none"> Complementary FET(CFET)は、N型FETとP型FETを垂直方向に積層して統合する次世代の半導体デバイス技術 現在主流のFinFETやGAA(Gate-All-Around)FETに続く技術として期待されている
CoWoS	<ul style="list-style-type: none"> Chip on Wafer on Substrateの略称。TSMCが開発した先進パッケージ技術の一つ。 複数のチップをシリコンインターポザー上に実装し、基板に搭載することで、高速・大容量のデータ処理と省スペース化を実現
DicifferX WAXS Edition	<ul style="list-style-type: none"> 高分子フィルム、繊維、薄膜などの材料における原子・分子構造、結晶相および分子配向を高精度かつ数秒以内に測定する先進的なX線分析装置
Electron Density Topography (電子密度トポグラフィー)	<ul style="list-style-type: none"> 結晶内部の電子の分布(電子密度)を可視化する技術。これにより、材料の原子構造や結合の状態を詳細に調べることが可能
EUV	<ul style="list-style-type: none"> Extreme Ultravioletの略称。波長が約13.5nmの紫外線を指し、半導体製造の露光プロセスで使用される光源技術
GAA	<ul style="list-style-type: none"> Gate-All-Aroundの略称。 トランジスト技術の一種で、ゲートがすべての側面からチャンネルに接触、継続的な小型化を可能にするトランジスタ構造を指す
GaN	<ul style="list-style-type: none"> ガリウム(Ga)と窒素(N)で構成される化合物半導体材料

用語	説明
GI-SAXS	<ul style="list-style-type: none"> Grazing Incidence Small-Angle X-ray Scatteringの略称。浅い角度の斜め方向からX線を照射し、材料表面近くの微細構造を非破壊で解析する手法。薄膜や表面のナノスケール構造の評価に利用される
HBM	<ul style="list-style-type: none"> High Bandwidth Memoryの略称。低消費電力かつ極めて広い帯域幅を持つ新型メモリチップ。スタック内およびメモリとロジックの間の両方で、極めて広いデータチャネルを提供する標準化された積層メモリ技術
High-k/Metal Gate	<ul style="list-style-type: none"> High-k材料とは高誘導率(high dielectric constant)を持つ材料のこと。High-k/Metal Gateとは、High-k材料と金属ゲートを組み合わせた最新のトランジスタ構造を指す
MiniFlex XpC	<ul style="list-style-type: none"> X線回折(XRD)を用いて材料の結晶構造を分析するためのコンパクトな装置であるMiniFlexシリーズに比べ、プロセス用途や自動化ラインとの連携を意識して開発されたモデル
NEX CG II	<ul style="list-style-type: none"> 次世代偏光光学系エネルギー分散型蛍光X線分析装置。各種油類や液体、固体、金属、ポリマー、生体試料、粉末試料、ペースト試料、コーティング試料、薄膜試料など、さまざまな種類の試料の主成分および微量成分に対し、迅速に定性分析および定量分析や膜厚測定ができる
ONYXシリーズ	<ul style="list-style-type: none"> エネルギー分散型蛍光X線分析(EDXRF)技術と光学技術を組み合わせたハイブリッド型分析装置。半導体パッケージなどの多層構造を非破壊でインライン評価可能。微小部の成分分析や3次元形状の測定に対応
Perovskite Solar Cell (ペロブスカイト太陽電池)	<ul style="list-style-type: none"> 「ペロブスカイト構造」と呼ばれる結晶を使った次世代型の太陽電池。軽量・低コストで製造でき、高効率な発電が可能のため、シリコンに代わる有力な材料として研究・開発が進んでいる
Pillar 3戦略	<ul style="list-style-type: none"> リガクが推進する「Lab to Fab戦略」のもと、多目的分析機器の活用領域を、研究開発用途から量産工程へと拡大・展開する取り組み

用語	説明
Qualana	<ul style="list-style-type: none"> 高い分析精度を備え、位置ずれのない微小領域および広域マッピングを高精度に実現する先進的なX線分析装置。軽元素までも高感度で検出し、リガク独自のFPプログラムにより、柔軟な薄膜定量分析をサポート
SiC	<ul style="list-style-type: none"> シリコン(Si)と炭素(C)で構成される化合物半導体材料
SiGe	<ul style="list-style-type: none"> シリコン(Si)にゲルマニウム(Ge)で構成される合金半導体材料
TFXRD	<ul style="list-style-type: none"> 半導体産業における薄膜特性の高精度な評価を目的としたX線回折(XRD)装置。特に、200mmおよび300mmの大口径ウェーハ上の薄膜の測定に対応しており、研究開発から製造プロセスのモニタリングまで幅広く利用されている
T-SAXS	<ul style="list-style-type: none"> Transmissive Small-Angle X-ray Scatteringの略称。透過型小角X線散乱法。物質にX線を透過させ、その散らばり方を分析することで、物質内部のナノメートルスケールの微細構造を非破壊で解析できる手法。半導体部品内部の微細な状態を詳しく確認する際に用いられる
WFE	<ul style="list-style-type: none"> Wafer Fab Equipment の略称。ウェーハを回路形成・検査するプロセスにおける製造装置を指す
XRD (回折)	<ul style="list-style-type: none"> X線回折(XRD)。結晶試料にX線を照射するときに生じる回折パターンから試料の結晶構造情報を得る手法
XRF (蛍光)	<ul style="list-style-type: none"> X-Ray Fluorescenceの略称。物質にX線を照射したときに発生する蛍光X線を利用して、定性分析や定量分析を行う元素分析手法

用語	説明
XRTmicron	<ul style="list-style-type: none">高輝度X線光源と専用光学系を用いた高分解能・高速X線トポグラフィ装置。 Si、SiC、GaNなどの単結晶材料に対応。結晶欠陥を非破壊、全自動で検出できることから、半導体生産の歩留まり向上に寄与できる
XtaLAB Synergy ED	<ul style="list-style-type: none">リガクの単結晶X線構造解析の要素技術と日本電子の透過型電子顕微鏡の要素技術を組み合わせて作られた電子線回折装置。 従来よりも微細な粉末状の結晶でも測定が可能。これまで解析が困難であった物質でも構造情報を得ることができる
ZSX Primus III NEXT	<ul style="list-style-type: none">定評のある上面照射型の走査型X線分析装置。生産管理で広く使われてきた汎用モデル「ZSX PrimusIII+」の後継機
ZSX Primus IV	<ul style="list-style-type: none">4kWの強力なX線を用いて、物質に含まれる元素を詳しく調べる波長分散型のX線分析装置